





발송번호: 9-5-2006-004226310
 발송일자: 2006.01.25
 제출기일: 2006.03.25

심사관	파트장	팀장	본부장	보고
				

특 허 청 의견제출통지서

출 원 인 명 칭 엘지노텍 주식회사 (출원인코드: 119980002855)
 주 소 서울 강남구 역삼동 736-1번지
 대 리 인 명 칭 허용택
 주 소 서울 강남구 역삼1동 642-15 송촌빌딩 8층

출 원 번 호 10-2004-0025310
 발 명 의 명 칭 발광 다이오드 및 그 제조방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법 시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1항, 제2항, 제4항, 제7항 내지 제10항 및 제13항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

본원의 특허청구 제1항, 제2항, 제4항, 제7항 내지 제10항 및 제13항은 기관 상에 형성된 질화갈륨층과 활성층 사이에 정전기 보호를 위한 다중층이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 발광 다이오드 및 그 제조방법에 관한 발명입니다.

그러나 첨부된 한국공개특허 제2004-29165호(공개일:2004.04.03., 이하 인용발명이라 함)에는 복수의 질화물 반도체층을 갖는 n측 영역과 복수의 질화물 반도체층을 갖는 p측 영역과의 사이에 활성층을 갖는 질화물 반도체 소자에 있어서, n측 영역 또는 p측 영역의 적어도 어느 것 하나에 2 종류의 질화물 반도체막이 적층되는 다중막층을 형성한 질화물 반도체 소자가 기재되어 있습니다.

본원과 인용발명간에는 질화물 반도체층과 활성층 사이에 다중층을 형성하는 발명의 구성이 유사하고, 이로부터 정전압을 높여 소자의 신뢰성을 향상한다는 발명의 효과면에서도 공통점이 있습니다.

따라서 상기 청구범위의 발명은 인용발명에 기재된 기술에 의해 용이하게 발명할 수 있습니다.

[참 부]

첨부1 한국공개특허 제2004-29165호(2004.04.03) 1부. 끝.

2006.01.25

특허청

전기전자심사본부
전자소자심사팀

심사관

최광섭



<< 안내 >>

명세서 또는 도면 등의 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 3,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 13,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.

보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허법·실용신안법·디자인보호법및상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요일·휴일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.

보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.go.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

기타 문의사항이 있으시면 ☎042)481-5746로 문의하시기 바랍니다.

서식 또는 절차에 대해서는 특허고객 콜센터(☎1544-6080)로 문의하시기 바랍니다.